

W_i – intrinsic (adalekolatlan) félvezetőben a Fermi-szint helyzete, másnéven sávközép [eV]
 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

W_F – Fermi szint energia szintje [eV]

W_c – vezetési sáv aljának energia szintje [eV]

W_v – vegyérték sáv tetejének energia szintje [eV]

W_g – tiltott sáv szélessége [eV]

k_b – Boltzmann állandó, $k_b = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ $[V \cdot A \cdot s/K]$

h – Planck állandó, $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}$

c – fénysebesség, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

n – elektron koncentráció [db/cm³]

p – lyuk koncentráció [db/cm³]

n_i – adalekolatlan félvezetőben a töltéshordozó koncentráció [db/cm³]

$\overline{J_n}$ – elektronok áramsűrűsége (egységnyi keresztmetszeten) [A/m²]

$\overline{J_p}$ – lyukak áramsűrűsége [A/m²]

q – elektron elemi töltése $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ $[A \cdot s]$

μ_n – elektronok mozgékonyága [m²/(V·s)]

μ_p – lyukak mozgékonyága [m²/(V·s)]

\overline{E} – térerősség vektor [V/m]

D_n – elektronok diffúziós állandója [m²/s]

D_p – lyukak diffúziós állandója [m²/s]

$\frac{kT}{q} = U_T$ – Termikus feszültség, szobahőmérsékleten 26 mV

$\frac{kT}{q}$ – Termikus energia, szobahőmérsékleten 26 meV

g_n – generációs ráta (elektronok) [1/m³s]

r_n – rekombinációs ráta (elektronok) [1/m³s]

τ_n – elektronok élettartama [s]

n_p – egyensúlyi elektron koncentráció p adalékolású régióban [db/cm³]

n_0 – átmenet közvetlen határán kialakuló elektron koncentráció p adalékolású régióban [db/cm³]

L_n – diffúziós hossz [m]

U_D – diffúziós feszültség [V]

N_d – donor adalékoltság szintje [db/cm³]

N_a – akceptor adalékoltság szintje [db/cm³]

S_p – kiürített réteg szélessége p adalékoltságú oldalon [m]

U_{np} – PN átmeneten eső feszültség [V]

I_0 – telítési áram [A]

I_G – generációs áram [A]

U_R – záró irányú előfeszítés nagysága [V]

C_T – tértöltés kapacitás [F]

C_D – diffúziós kapacitása [F]

Q_D – diffúziós töltésmennyiség [C]

$r_d = U_T / I$ – dióda differenciális ellenállása [Ω]

I_C – kollektor áram [A]

I_E – emitter áram [A]

A – földelt bázisú, egyenáramú áramerősítési tényező

η_e – injektálási/emitter hatásfok

η_{tr} – transzfer hatásfok

I_{CB0} – lezárt bázis-kollektor átmenet záróirányú (telítési) árama [A]

$N_B(0)$ – bázis adalékoltsága az emitter oldalon [db/cm³]

$N_B(w_B)$ – bázis adalékoltsága a kollektor oldalon [db/cm³]

w_B – metallurgiai bázisszélesség [m]

r_s – dióda soros ellenállása [Ω]

U_0 – elzáródási feszültség (V_p angol nevezékneve) [V]

I_D – drain áram [A]

I_{DSS} – JFET telítési árama (I_o magyar szakterminológiában) [A]

Φ_F – fermi potenciál értéke [V]

U_F – felületi potenciál nagysága [V]

Φ_{MS} – kilépési munkák különbsége, fém-félvezető átmenet potenciálkülönbség nagysága [V]

Q_{SS} – felületi elkötetlen állapotok töltése [C]

C_0 – felületegységre eső oxidkapacitás [F/m²]

Φ_{FB} – flat-band potenciál [V]

γ – bulk együttható [V^{1/2}]

P_{CP} – töltéspumpálásból (charge pump) adódó fogyasztás-összetevő [W]

C_L – logikai áramkörökben a kimeneteket terhelő átlagos szórt/parazita kapacitás értéke [F]